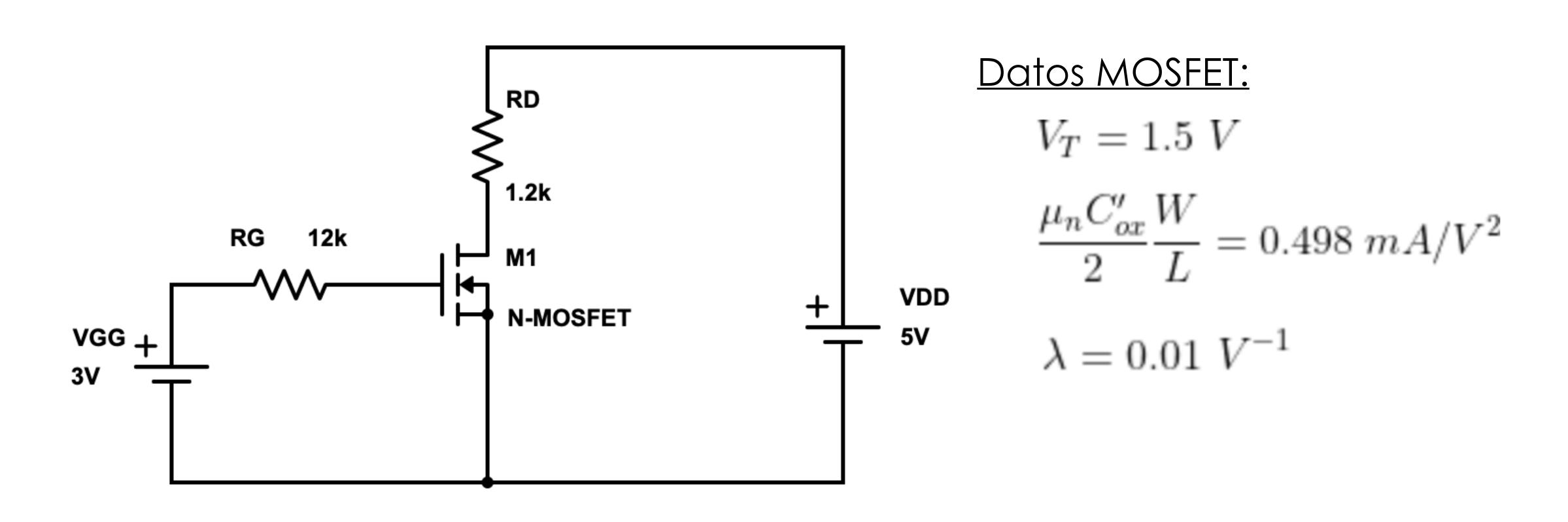
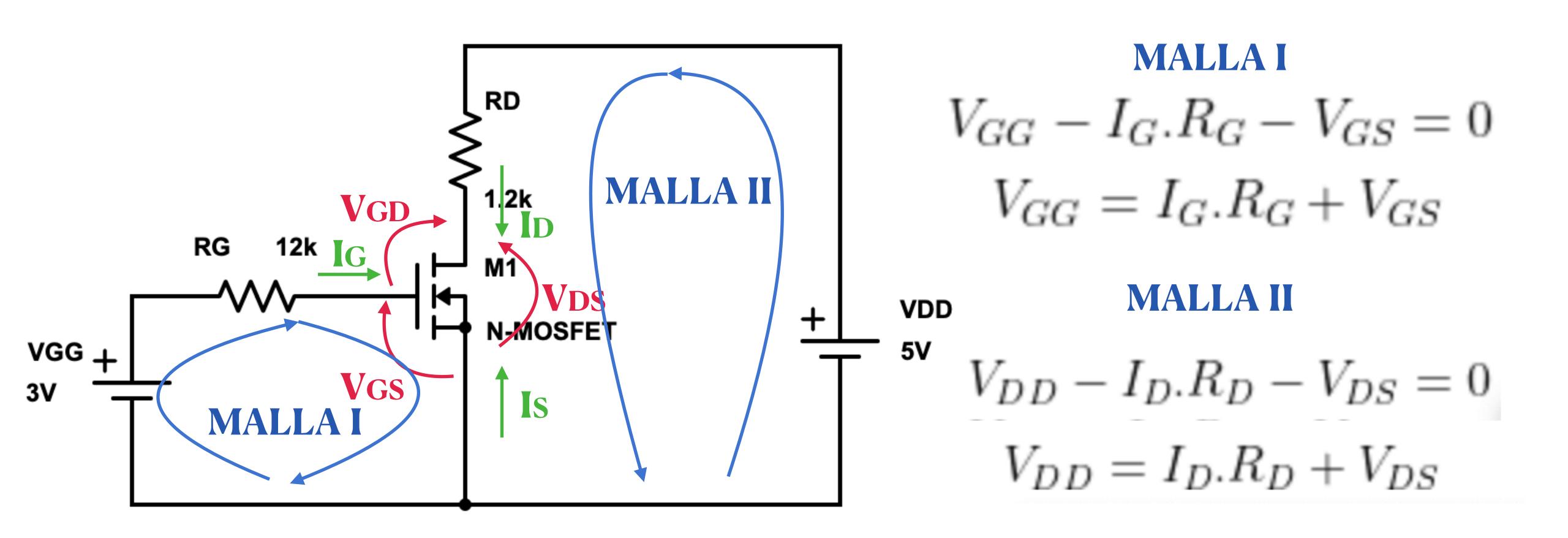
# POLARIZACIÓN MOSFET

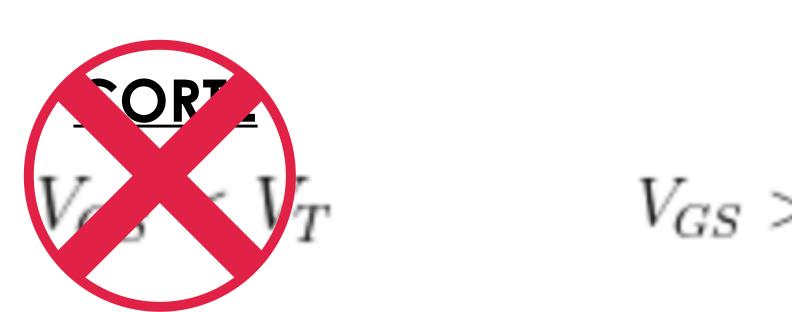
Obtener el punto de polarización (VDS, ID) del transistor MOSFET.



## ANÁLISIS DE CORRIENTES Y TENSIONES - MALLAS



### REGÍMENES MOSFET

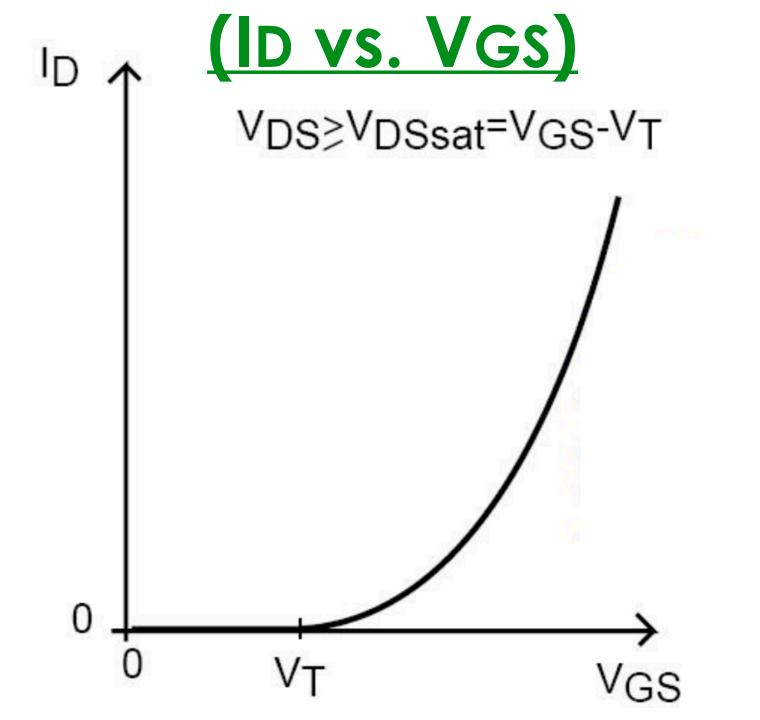


#### **SATURACIÓN**

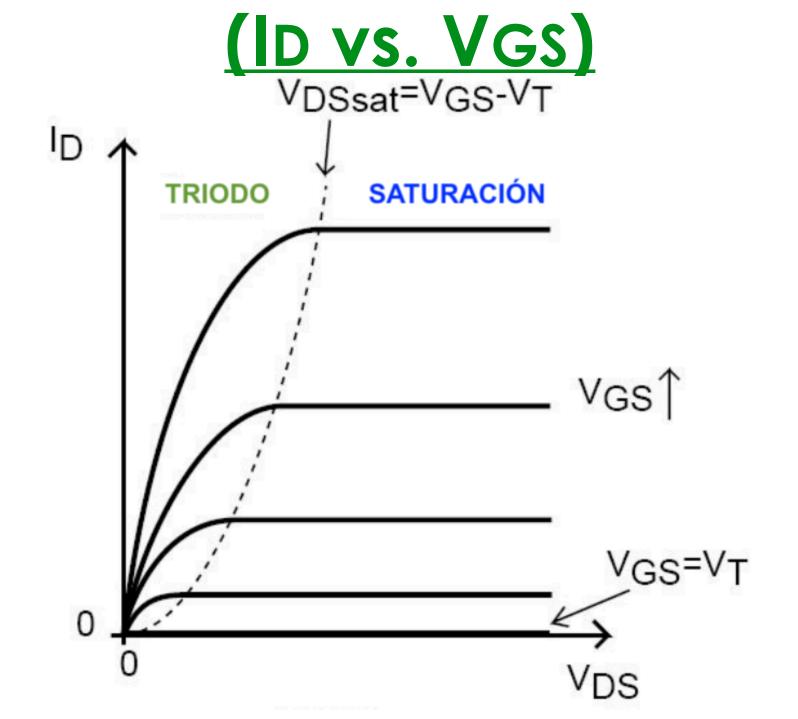
 $< V_{DS_{SAT}}$   $V_{GS} > V_T; V_{DS} > V_{DS_{SAT}}$ 

# SUPONEMOS QUE EL TRANSISTOR SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL RÉGIMEN DE SATURACION

#### Curva de transferencia



#### Curva de transferencia



#### <u>Datos:</u>

$$V_T = 1.5 \ V$$

$$\frac{\mu_n C'_{ox}}{2} \frac{W}{L} = 0.498 \ mA/V^2$$

$$\lambda = 0.01 \ V^{-1}$$

$$V_{GG} = 3V$$

$$V_{DD} = 5V$$

$$R_D = 1.2k\Omega$$

$$R_G = 12k\Omega$$

### RESOLVEMOS

$$I_{D} = \frac{\mu_{n} C'_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{T})^{2} \left(1 + \lambda (V_{DS} - V_{DS_{SAT}})\right) \qquad \lambda \cong 0$$

$$I_{D} = \frac{\mu_{n} C'_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{T})^{2}$$

Utilizando la expresión de la malla I obtenemos el valor de VGS

$$V_{GG} = I_G.R_G + V_{GS} \longrightarrow V_{GS} = V_{GG} - I_G.R_G = 3V \qquad I_G = 0$$

$$I_D = \frac{\mu_n C'_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2 = 1.12 mA$$

Utilizando la expresión de la malla II e ID obtenemos el valor de VDS

$$V_{DD} = I_D.R_D + V_{DS} \longrightarrow V_{DS} = V_{DD} - I_D.R_D$$

$$V_{DS} = 3.656V$$

### VERIFICAMOS SATURACIÓN

Recordamos las condiciones de saturación y las analizamos:

$$V_{GS} > V_T$$



$$V_{DS} > V_{DS_{SAT}}$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_T$$

$$3.656V > 3V - 1.5V = 1.5V$$



Corroboramos que nuestro MOSFET trabaja en SATURACIÓN

### PASOS A SEGUIR PARA POLARIZACIÓN

- 1. Planteo corrientes y tensiones de circuito
- 2. Obtengo las expresiones de las mallas que lo componen
- 3. Supongo régimen de saturación
- 4. Resuelvo
- 5. Verifico si es correcta la suposición de saturación
- 6. Si la suposición fue errónea, planteo otro regimen y vuelvo al punto 4 hasta encontrar un resultado acorde con la suposición

### POLARIZACIÓN CON FUENTE ÚNICA

